

1 ОСОБЕННОСТИ

- Интерфейсный контроллер
- Напряжение питания от 3,0 В до 3,6 В;
- Максимальная тактовая частота шины PCI 33 МГц;
- Диапазон рабочей температуры: минус 60 – 85 °С;
- Стойкость к воздействию спецфакторов 7.И1, 7.И6, 7.И7, 7.И8, 7.С1, 7.С4, 7.К9, 7.К10, 7.К11, 7.К12 повышенная;
- Тип корпуса: 240-х выводной металлокерамический корпус МК 4245.240-6.01;

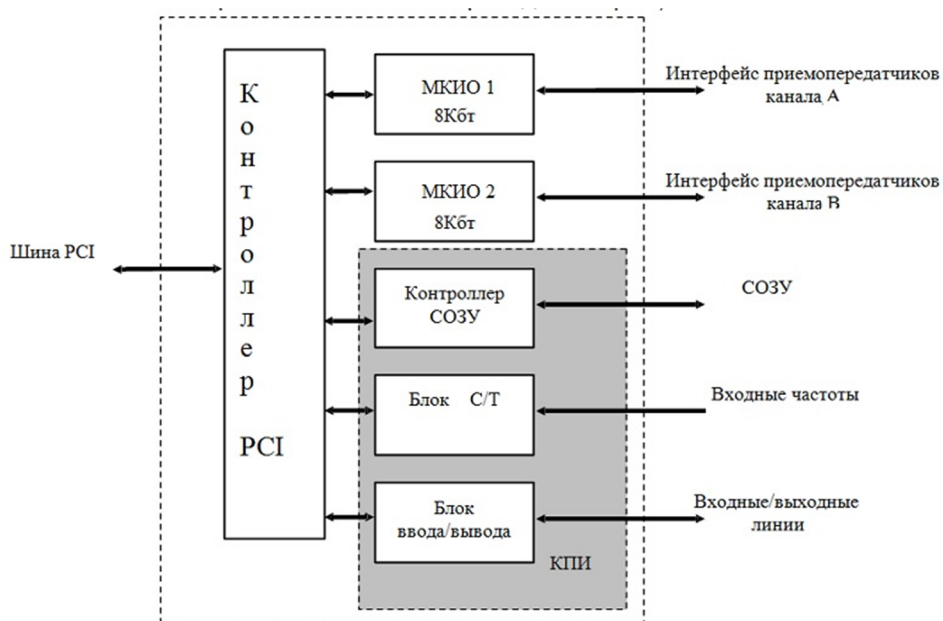
2 ОПИСАНИЕ

Микросхема интерфейсного контроллера с повышенной стойкостью к специальным воздействующим факторам обеспечивает подключение двух независимых мультиплексных каналов с резервированием к вычислительной системе с шиной PCI. Устройства мультиплексного канала соответствуют ГОСТ Р 52070-2003 для PCI систем. Также микросхема интерфейсного контроллера, являясь контроллером специальной памяти, позволяет подключить блок статического ОЗУ организацией 8192*32 бит. Микросхема обеспечивает обработку входных частот, обеспечивает параллельный прием 16 потенциальных входных сигналов уровня КМОП и формирование программным путем через системную магистраль PCI 16 выходных сигналов уровня КМОП.

3 ПРИМЕНЕНИЕ

Микросхема предназначена для комплектования радиоэлектронной аппаратуры специального назначения.

4 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Обозначение параметра	Норма		Температура, °С
		не менее	не более	
Выходное напряжение низкого уровня, В, ($U_{CC}=2,97$ В, $I_{OL}=4$ мА)	U_{OL}	–	0,4	от -60 до +85
Выходное напряжение высокого уровня, В ($U_{CC}=2,97$ В, $I_{OH}=4$ мА)	U_{OH}	2,4	–	
Динамический ток потребления максимальный, мА ($U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=2,4$ В, $U_{IL}=0,6$ В, $f_{KT}=12$ МГц, $f_{PC}=33$ МГц)	I_{OCC}	–	300	
Динамический ток потребления рабочий, мА ($U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=3,63$ В, $U_{IL}=0,0$ В, $f_{KT}=12$ МГц, $f_{PC}=20$ МГц)	I_{OCCr}	–	200	
Динамический ток потребления рабочий в режиме энергосбережения, мА, ($U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=3,63$ В, $U_{IL}=0,0$ В, $f_{KT}=0$ МГц, $f_{PC}=20$ МГц)	I_{OCCL}	–	100	
Ток потребления статический, мА, ($U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=2,4$ В, $U_{IL}=0,6$ В)	I_{CC}	–	70	
Ток утечки высокого уровня на входе, мкА, ($U_{IL}=0$ В, $U_{IH}=5$ В, $U_{CC}=3,63$ В)	I_{ILH}	–	30	
Ток утечки низкого уровня на входе, мкА, ($U_{IL}=0$ В, $U_{IH}=5$ В, $U_{CC}=3,63$ В)	I_{ILL}	-30	–	
Ток утечки высокого уровня на выходе в состоянии «Выключено», мкА, ($U_{IL}=0$ В, $U_{IH}=5$ В, $U_{CC}=3,63$ В, $U_{OH}=5,5$ В)	I_{OZH}	–	30	
Ток утечки низкого уровня на выходе в состоянии «Выключено», мкА, ($U_{IL}=0$ В, $U_{IH}=5$ В, $U_{CC}=3,63$ В, $U_{OL}=-0,2$ В)	I_{OZL}	-30	–	
Ток низкого уровня на входе, привязанном к U_{CC} , мкА ($U_{CC}=3,63$ В, $U_{IL}=0,0$ В)	I_{ILPU}	-400	мину с 2	
Ток высокого уровня на входе, привязанном к общему уровню, мкА ($U_{CC}=3,63$ В, $U_{IH}=5,0$ В)	I_{ILPD}	2	400	
Входная емкость, пФ	C_I		12	
Емкость входа/выхода, пФ	$C_{I/O}$		20	25 ± 10
Выходная емкость, пФ	C_O		20	25 ± 10

6 ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

